

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

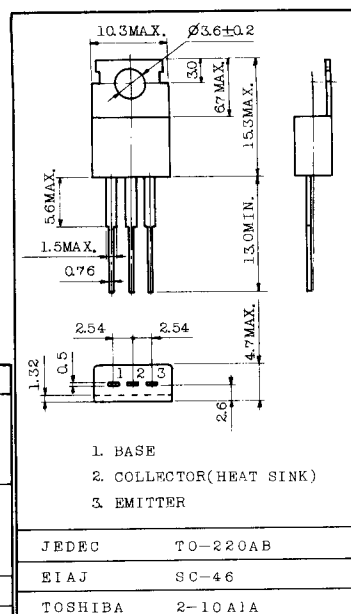
2SA968・2SA968A
2SA968B

- 電力増幅率
- 励振段電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- Driver Stage Amplifier Applications.

- ・ トランジション周波数が高い。: $f_T=100\text{MHz}$ (Typ.)
- ・ 2SC2238 とコンプリメンタリになります。
- ・ Can Type (TO-66) の 2SA969 もあります。
- ・ Complementary to 2SC2238.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	2SA968	-160	V
	2SA968A	-180	
	2SA968B	-200	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA968	-160	V
	2SA968A	-180	
	2SA968B	-200	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	A
エミッタ電流	I_E	1.5	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



アクセサリは AC75 を適用
MOUNTING KIT No. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-160\text{V}$, $I_E=0$	—	—	-1.0	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}$, $I_C=0$	—	—	-1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SA968	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$	-160	—	—	V
	2SA968A		-180	—	—	
	2SA968B		-200	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-1\text{mA}$, $I_C=0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-100\text{mA}$	70	—	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$	—	—	-1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$	—	—	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-10\text{V}$, $I_C=-100\text{mA}$	—	100	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$, $I_C=0$, $f=1\text{MHz}$	—	30	—	pF

Note: h_{FE} 区分/ h_{FE} classification O: 70~140, Y: 120~240